

(1) 電力線 (E lines) 是電通量 (electric flux, 用  $\Phi_E$  表示)

。具體化  $\vec{E}$  = 用 E lines 表現

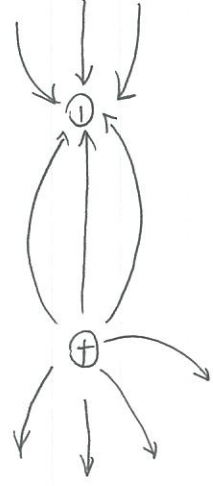
E 的特點: 大小, and 方向

∴ E lines 常表現  $|\vec{E}|$  及  $\vec{E}$  的方向: 方向以箭頭表示,

$|\vec{E}|$  的強弱則以 E line 的密度表現。

E lines 的性質:

(i) + 電荷發出, 終止於  $\infty$  或負電荷



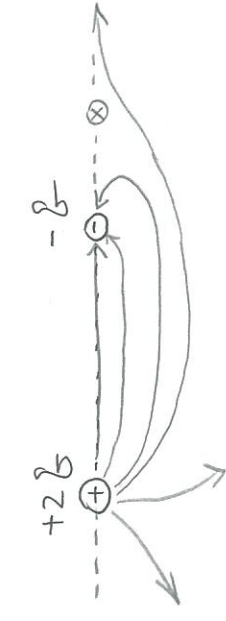
(ii) 電荷上發出或終止的 E line 數目  $\propto$  電荷大小。

(iii) E line 上 P 點的切線方向 = P 點上  $\vec{E}$  的方向

(iv)  $|\vec{E}| \propto$  E line 密度。

(v) ∴ superposition principle ∴ E lines 不交叉 (交叉點表示有兩個切線方向)

例子:  $2q$  及  $-q$  系統的 E lines: 對稱、近場、遠場,  $E=0$  的點 (Benson Example 23.3)



(i) 連心線的上、下部 E line 對稱

(ii) 近場: E lines 徑向輻射且球狀對稱。

(iii) 遠場: E lines 是  $2q - q = q$  的形狀

(iv) 在連線上有一處  $\otimes$   $|\vec{E}|=0$  的地方。

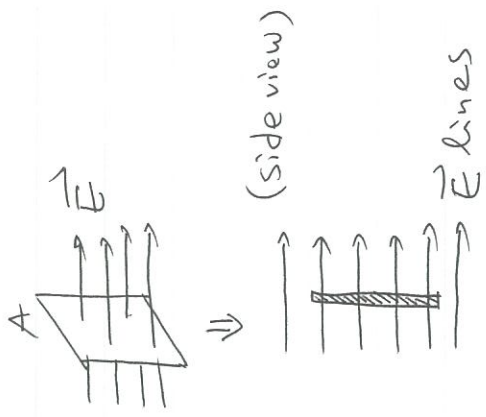
(v) E lines 數目:  $2q$  是  $-q$  的兩倍。



0 電通量  $\Phi_E$

(i)

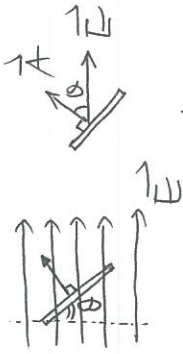
將一面積為  $A$  的面垂直  $\vec{E}$ , 放入均勻  $\vec{E}$  中, 則稱通過  $A$  的  $\Phi_E = E \cdot A$ , 如右圖。



但如  $A$  与  $\vec{E}$  非垂直, 則通過  $A$  面積的電力線數目減少, 如下圖所示, 則

$$\Phi_E = EA \cos \theta$$

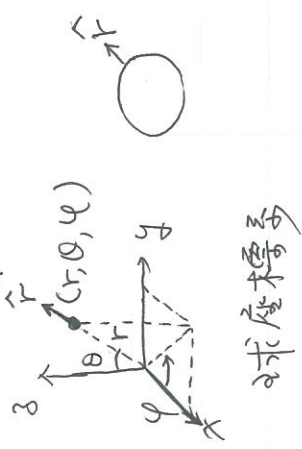
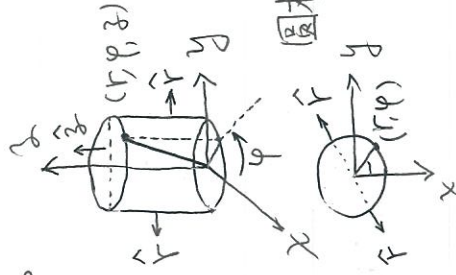
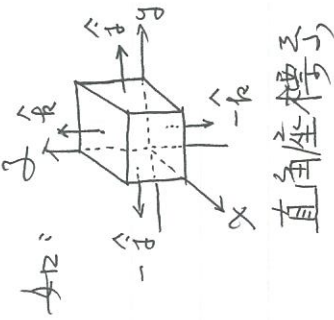
如將平面  $A$  的法線向



$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = E \cdot A \cdot \cos \theta$$

(But: 一個平面的法線向量有兩個方向, which one?)

(ii) 在電磁學中, 重要的是對閉曲面的討論, 定義封閉曲面的方向 = 向外。



(iii) For 不規則的封閉曲面, 則分割成很多的微細面積  $d\vec{A}$  and  $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ , where  $\oint$  表示對閉曲面的積分。

(In fact, 只有高度對稱的封閉曲面才能算出  $\Phi_E$ ).



## (2) Gauss law

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{enclosed}} / \epsilon_0$$

or simply,  $Q_{\text{enclosed}} = \epsilon_0 \Phi_E$ , where

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2 = \text{permittivity constant.}$$

⇒ 穿過一個封閉曲面 (~ Gaussian surface) 的  $\Phi_E$  乘以  $\epsilon_0$   
= 曲面所包圍的淨電荷  $Q_{\text{enclosed}}$ 。



(1) Gauss law ⇒ Coulomb law

Choose radius =  $r$  的 Gaussian surface.

→  $+Q$  的  $E$  徑向輻射向外,  $\therefore E \parallel d\vec{A}$

→ Gaussian surface 上每一點距離  $r$  有

相同距離,  $\therefore$  在 Gaussian surface 上的  $E$  為定值。

$$\therefore \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA = E \oint dA = E \cdot 4\pi r^2 = Q / \epsilon_0$$

$$\therefore E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} = Q \text{ 所建立的電場}$$

$$\text{置 } q \text{ 於 } E \text{ 中, 則作用在 } q \text{ 上的力 } F = qE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2} = \frac{kqQ}{r^2}$$

~ Coulomb law.

o Gauss law 的運用: 對稱性

用 Gauss law 求  $E$  的 key point 為 Gaussian surface 的選擇。

(a) 由 charge 的對稱分布決定  $E$  lines 的形狀和方向。

(b) Gaussian surface 的選擇:  $d\vec{A} \perp E$  lines or  $d\vec{A} \parallel E$  lines.

Examples: 21.1 ~ 21.6 (含觀念例題 2.1)

⇒ Fig. 21.19

$$2D \sigma \Rightarrow E \propto r^0$$

$$1D \lambda \Rightarrow E \propto r^{-1}$$

$$0D \text{ point} \Rightarrow E \propto r^{-2}$$

$$\text{dipole} = E \propto r^{-3}$$

$$\text{quadrupole} = E \propto r^{-4}$$





## (3) Gauss law and conductors

↳ 只有熱隨機 motion.

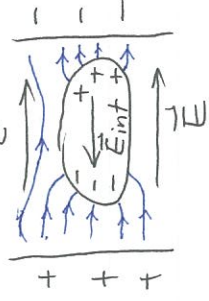
- 靜電平衡 (electrostatic equilibrium) = 導體內自由電荷的淨位移為零。  
(or free charges stop to move), 此時自由電荷的淨受合力 = 0.

In conductors: free charges are readily to move in  $\vec{E}$ .

∴ Put conductor in  $\vec{E}$ , when

$\vec{E}_{int} = \vec{E}$ , free charges stop to move,

∴ 在 conductor 內的 net  $\vec{E} = 0$



∴ 靜電平衡  $\Leftrightarrow$  Conductor 內的  $\vec{E} = 0$ .

(if conductor 內的  $\vec{E} \neq 0$ , 則其驅使 free charges 移動至靜電平衡).

of course, 靜電平衡是正現象.

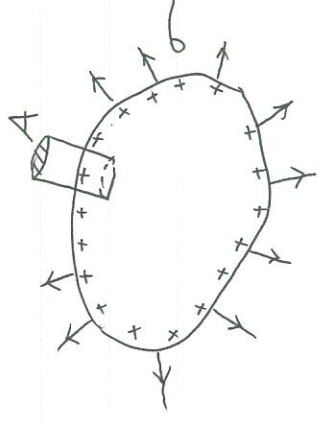
∴ Conductor 外的  $\vec{E}$  lines 垂直 conductor 表面, 如有平行表面的分量, 將驅使 free charges 移動.

- When conductor 帶電且達靜電平衡時, 則這些電荷分布在表面。

∴ 達靜電平衡, ∴ conductor 內的 net  $\vec{E} = 0$ , 依 Gauss law, 若 Gaussian surface 從內部無限靠近表面, 其  $Q_{enclosed} = 0$ , ∴ Conductor 所帶 excess 電荷必須分布在表面。



○ 導體表面的  $\vec{E}$ , 如右圖的 Gaussian surface



上端面有  $E$  lines 通過, 下端面處於導體內,  $\therefore \vec{E} = 0$

$$\therefore E \cdot A = A \cdot \sigma / \epsilon_0 \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

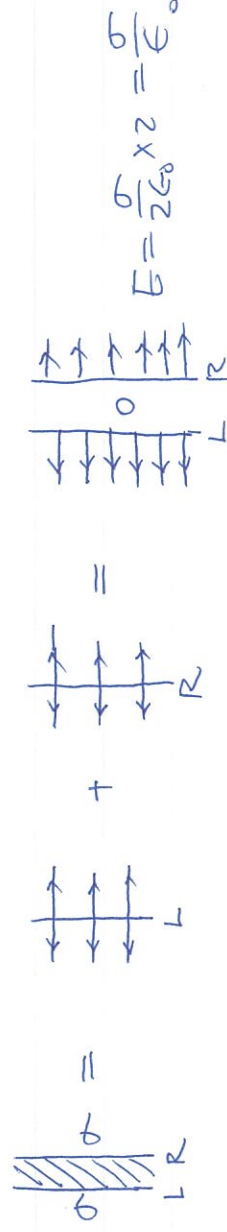
( $E \propto \sigma$ ,  $\therefore$  電子設計應避免產生高  $\sigma$ )

Although  $E \propto \sigma = \text{local charge density}$ ,  $E$  does not arise from the local density because the charges arrange themselves in such a way that  $\vec{E}$  at any point depends only on  $\sigma$  right at that point — even though  $\vec{E}$  arises from all charges on the surface. (see below)

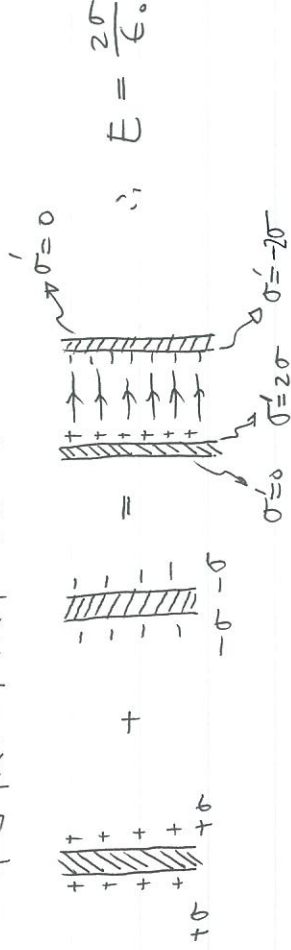
若一孤立的 thin 導體板, 只有一面具有  $\sigma$ , 則其表面的  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ , 但 Example 21.6 的結果顯示其表面的  $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ .  $\Rightarrow$  何處矛盾?

Ans:  $\hookrightarrow$  無限大 2D-plane

不會有 charges 只分布在一面的 thin 導體板, charges 必須平均分布在 conductor 表面!  $\therefore$  一面為  $+\sigma$ , 另一面也必須是  $-\sigma$ ,  $\therefore$



另例: put two isolated-charged 導體板 (各有  $\sigma$  and  $-\sigma$ ) 薄近形成平行板, 則板中的  $E = ?$



(Note: 此例與課本的最後一例, 於 p 366, 不同!)



21.1

✓

A uniformly charged sphere ( $Q, R$ ), find  $\vec{E}(r) = ?$

$\Rightarrow$  check the symmetry of charge distribution: 球狀對稱

$\therefore$  choose Gaussian surface = spherical surface of radius  $r$

(i)  $r > R$

$$\therefore \vec{E} \parallel d\vec{A}, \therefore \Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cdot dA$$

從高斯面上每一個點去看 charge 分布都相同,  $\therefore$  在高斯面上的  $E$  都相同,  $\therefore \oint E \cdot dA = E \oint dA = E \cdot 4\pi r^2$

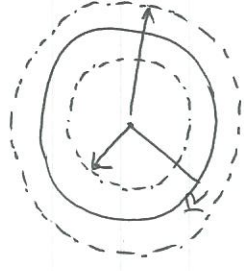
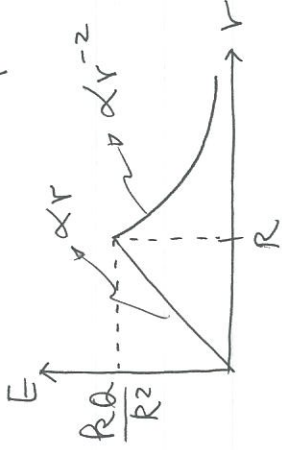
Next,  $Q_{\text{enclosed}} = Q$  when  $r > R$ .

$$\therefore E(r > R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, \quad \vec{E} \text{ 方向} = \hat{r} \text{ (why?)}$$

(ii)  $r < R$

The same as (i), except  $Q_{\text{enclosed}} = \frac{r^3}{R^3} Q$  when  $r < R$

$$\therefore E(r < R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3} \frac{Q}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot r, \quad \vec{E} \text{ 方向} = \hat{r} \text{ (why?)}$$



21.2 A uniformly charged hollow spherical shell ( $Q, R$ ), find  $E(r) = ?$

Similar to 21.1,  $E(r > R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ , but

$E(r < R) = 0$  because  $Q_{\text{enclosed}} = 0$

$\Rightarrow$  球殼內各處的  $E = 0$ .

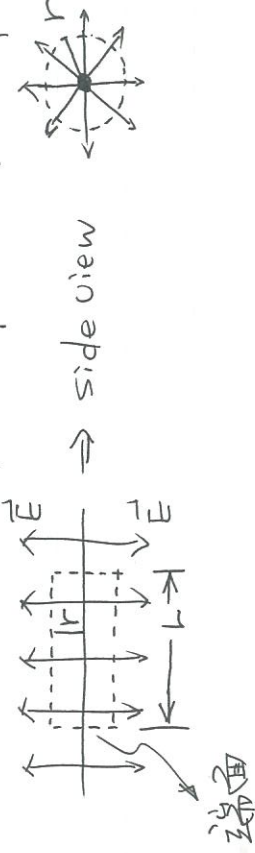




21.4

無限長的 charged line of charge density  $= \lambda \text{ C/m}$  的  $E(r) = ?$   
 $r =$  沿着 line 的距離。

check:  $\vec{E}$  的方向: 以 line 為中心輻射向外 (why?)



choose 長  $L$ , 半徑  $r$  的圓柱體作為 Gaussian surface,  $\therefore$   
 端面的  $d\vec{A} \perp \vec{E}$ , 圓柱面的  $d\vec{A} \parallel \vec{E}$

$$\therefore \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{\text{柱面}} E \cdot dA = Q_{\text{enclosed}} / \epsilon_0 = \lambda \cdot L / \epsilon_0$$

$\therefore$  半徑  $r$  的柱面上每點所看到的電荷分布皆相同,  $\therefore$  柱面上的每點皆有一樣的  $E$  值,  $\therefore \int_{\text{柱面}} E \cdot dA = E \cdot \int_{\text{柱面}} dA = E \cdot (2\pi r \cdot L)$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}, \text{ 方向: } \hat{r} \text{ (輻射向外)}$$

21.6 無限大的 sheet 帶有均勻的 surface charge density  $\sigma \text{ C/m}^2$ , 則 sheet 外的  $E = ?$



check  $\vec{E}$  的方向: sheet 的

兩側向外,  $\therefore$  choose

圓柱體面或長方體面為 Gaussian surface, 設端面之面積為  $A$ .  
 $\therefore$  端面  $d\vec{A} \parallel \vec{E}$ , 側面的  $d\vec{A} \perp \vec{E}$

$$\therefore \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{\text{端面}} E \cdot dA = E \cdot \underbrace{\int_{\text{端面}} dA}_{= 2A} = Q_{\text{enclosed}} / \epsilon_0 = \frac{A \cdot \sigma}{\epsilon_0}$$

$E$  在端面為固定值, (why?)

$$\therefore E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \text{ 方向: 向外.}$$

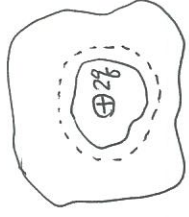
$\Rightarrow$  無限大的意義. (prob 20.71)

$\Rightarrow$  觀念例題 21.1 (p363)



21.7

不规则中空导体带 $+Q$ ，空腔内另有 $+2Q$ 的 point charge. 在静电平衡下，内腔壁及外表面的净电荷为何？(i.e. 导体上的电荷分布为何？)



内腔壁的 charge: 如右图的 Gaussian surface ( $\infty$  靠近内腔壁),  $\therefore$  在 conductor 中,  $\therefore E=0 \Rightarrow Q_{\text{enclosed}}=0$   
 $\therefore$  内腔壁的 charge 为  $-2Q$ .

Conductor 的 total charge =  $Q$ ,  $\therefore$  有  $+3Q$  的 charge 分布在外表面.

